MULTICHIP MODULE

Patent Number:

JP7131063

Publication date:

1995-05-19

Inventor(s):

ITO SOICHI

Applicant(s)::

NEC CORP

Application Number: JP19930273338 19931101

Requested Patent:

☐ JP7131063

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L31/12; H01L21/82; H01L27/15

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To enhance the performance of a multichip as a whole while reducing the clock skew by employing means for transmitting an optical clock signal between the multichips.

CONSTITUTION: The multichip module 11 comprises a semiconductor chip 13 comprising a function block 15, a light receiving element 100, a function block 16, and a light receiving element 101, a semiconductor chip 14 comprising a function group 17, and a light receiving element 102, and a semiconductor chip 18 comprising a light emitting element 19. The light emitting element 19 is provided with an electric clock signal from the external terminal 12 of the multichip module 11 through a wiring 103 and the electric clock signal is converted into an optical signal. The optical signal is received by the light receiving elements 100-102 and converted into an electric signal which is delivered to the function blocks 15-17.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-131063

(43)公開日 平成7年(1995)5月19日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	F I		技術表示箇所
H01L		Z	7210-4M			
	21/82					
	27/15	D	8832 - 4M			
			8122-4M	H01L 21/82		W
				審査請求 有	請求項の数 6	OL (全 7 頁)
(a.) Humani El Aberrer 070000				(71) LUBS I 000004997		

(21)出願番号

特願平5-273338

(22)出願日

平成5年(1993)11月1日

(71)出顧人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 伊藤 荘一

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

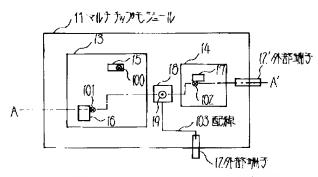
(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54) 【発明の名称】 マルチチップモジュール

(57)【要約】

【目的】マルチチップモジュールにおいて、クロック信号をマルチチップ間で光信号で伝送する手段を用いることにより、マルチチップモジュール全体としての性能の向上と、クロックスキューの低減をする。

【構改】マルチチャでモジョール11匹に機能でロック15記よび受光素子100元機能でロック16記よび受光素子100元機能でロック16記よび受光素子100元素を13元、機能でロック17記よび受光素子102元を有する半導体チャで13元、発光素子19元はマルチチャでモショール110年就増入12から配線103元分でではコックの電気信号が存立され、発光素子19元よって产信号に等機される。その先信号を投光者子100十102が発信し、電気行号に多様されて同様でコーク15・17に開始された。より、構成される。



13,14,18: 半導体 かプ

19:発光素子

15~ 17: 機能プロック

100~102:受光素于

【特許請求の範囲】

【請求項1】 1つのモジュール基板上に所定の機能を 有する複数の半導体チャブが搭載され、これら複数の半。 導体チップ間と外部端子間とが所定の導体バターンで接 続されたマルチチップモジュールにおいて、前割複数の 半導体チェプのうち少なくとも1つが受光素子を有し、 この受光素子に光信号を与える光信号供給手段を備えた ことを特徴とするマルチチャプモジュール。

【請求項2】 前記複数の半導体チップのじち上なべと 特徴とする請求項1記載のマルチチップモジュール。

【請求項3】 前部光信号供給手段は、前部モニュール 基板および前記複数の半導体チェブが所定のパェケージ に封入され、かつ前記パッケージと前記複数の半導体チ ップとの間は所定の大きさの空洞が設けられ、かつ前記 発光素子、前記受光素子以外の前記半導体チャプ表面と 前記資洞内面および前記モジョール基板表面には前記光 信号を反射する反射層が形成されていることを特徴とす る請求項1記載のマルチモ、プモジュール。

【請求項4】 前記光信号供給手段は、前記空間内の上 20 面および側面の少なりとも一方の面上に、各部に接続さ 利だモアマイが一線路の終端部が配設され、この終端部 から前記元信号が前記役元素子に供給されるように構成 されることを特徴とする諸古項1記載のマッチチャプチ . La mar I a

【請求項3】 前記元信号供給手段は、前記モジューン 基板および前記複数の主導体チャブが前記ハッツージに 封入され、かつ前記 5~~~. 宅前記複数 半半導体チャ べとの間は所定の式ささい間周が設けられ、かつ前記巻 元素子と前記受光素子以外の前記半導体チ、ご表面およ 30 び前記モニュール基板表面には前記元信号を吸収する非 反射層が形成され、前部控制四面には前部反射層が形成 されていてことを特徴とする請求項1記載のマコチチン

【諸邦順6】「前記(ドーナー)。に封入されたい)となくと ち1組のマンチディブモデューもの前組複数の主導体デ > 「搭載衛が対りするように新定つ距離を保って配置さ 和、一方の前部にかチチャブモスは一つに前記輸元素子 乃搭載され、他市(前計マルチチャブをジュー)に前計 性光素子の搭載されたことを特徴とする請求項目および。 2記載のマルチチンプキリューす。

【新明白評細な規則】

[0.001]

【葡萄七二利甲分析】な発明はつい流流には、 に係わり、嫌いに ・チザーフラン アーコに搭載しれる ※ 遭仗不 计型工作人工数据经验证明性状态

【0002】

【何明 自然】作品点,所谓的别人不是。 lens to - 孝,言,杨庙也也一定遭仗慧暐。孙([() 元 孝。 製いで、主動御墓板に因数し、エチで10里を模点した。 道 、 ※ はNFでして、藤輝いでとしては韓州『絵を構造す

シフテムを構成していた。しかしながら、半導体技術の めざましい進歩と、これらのICを設計するCAD(C omputer Aided Design)技術の改 善に伴ない、ユーザ側の要求するシステムに対応できる よりに考慮された特定用途向けのIC、すなわちASI 亡が普及してきた。

【0003】そのため、前辺した標準10をできるだけ 1チップに集積化することによりこですよを構成する装 置の小型化、たるいはコスト低減、さらにはその装置の も1七は前記光信号を発生する発光素子を育することを「10」性能向上を図るために、システム・オレ・エドコンの動 きが活発になってきた。

> 【0004】このよりな状況下にあって、ルフラムの性 能を向上させるには、1チ、プ化したチップ内にステム における信号も処理連度を高速化することが必要であっ り、そのためにいわゆるデザインコール(Design rule)と称するICチップのマスターさいの設計 基準の縮小化が行なわれてきた。その結果、上対したユ 一冊のいステム性能の向上に力き。寄与できるようにな。 ってきている。

【0005】しかし、従来のシアサムでは問題とはなら ながったチップ内の割線に制用する信号伝達の選強時間 つばらつきが、ICチャプロンフテムの性能向上に大き な妨げしなってきている。

【0006】は来のマルチチュプルチュー。 汁一倒を示 . 九辺9を参照する し、外別燐チ92から入れらたカコ -- * 信号は、配線903点~してチャブ93、94つ各 入力蝎子904および905に接続され、各1Cチップ つたたべっマッ906、907を経た後、糸10千っぱ 内の配練908、909により機能だユンク95~97 (に))ローク信号が供給されるよりに構成される。こづよ うた構成によると、何えば、クロッと信号を10チャブ 内○複数機能プロックに分配する場合、信号法信点外部 端午92から信号受信点機能プロップ95~97に至る 距離、すなわち、配線負荷容量の度合が異るため、本来 は複数の配信用で同一タイトンでとなる必要がわるクロ 7、信号にもがかわてず、 れつの信号の位相がずれて 注い円面を動作をしないことがある。

【0007】よりよーな段動作を防っために、例えば、 ·ナスカップ アウト設計時点、暗ボコ(言手もなべミング会 40 世川の農众配線経路につきては、タイミング 特許客入れ らばそっきの範囲内に納まらよ。に配導長を調整する、 に因ねるカロータ・プロー・、 だいス別物学の事故、 あるいは、信号配理 UI(配理域和)f(f) (間線浮量値) [[成本广天月時間数日聽餐中心。引品が療物。hitch [計 神庙主活散中心并述《五七

【0008】 称作。 146 入25、 蘇聯/761 61 作り上が会議には「戦」といている。 おないも、 はばし置 基 ·扫书、编建了位、引力要数据等增入时,本门心中主意。 (1) 種事 は2分は上、自集体を必要を行っ

る電気素子に結合した半導体光検出素子が一体化形成されている。これら論理ユニットにクロック信号を供給する場合は、クロック信号を半導体発光素子に供給し、クロック信号に応じた元信号を放出させ、この光信号を各論理ユニットごとの光検出素子で一斉に検出され、この検出されたフロック信号が論理ユニットの論理回路を構成する電気素子に供給されるようにしている。

【0009】含らに他の手法の例が、特開平1~228 008号公報に記載されている。この手法は、発光素子 を内蔵したクロック発生回路と各種論理プロックとが光 10 導波路で接続され、外部から供給されたクロックの原発 振信号かクロック発生回路で基本クロック信号に分周さ れた後、発光素子により光に変換され光導波路を伝播さ れて各種論理プロック内ではこの受光回路に入射される。各種 論理プロック内ではこの受光回路により光信号が基本クロック信号に戻され、分周された後各種論理回路に供給 されるとしている。

[0010]

【発明が解決しよう日本の課題】上述した従来の手法のうち、クローク・ファヤン・シャロングの手法は、クロック信号が分配される対象機能でロックの形成に10年少で内部の配線位置から厳密に配線長を調整することは出来ず。さらに配線相互の隣接および交叉によら時定数つばらつきを正確に反映させることはCADシートに多て公負担合なり、そのが理時間の増大をよびマッツ容量の増大を招いている。すなわちこの手法には10年ップのコステム性能向上に当果がある。

【0012】な発明の目的は、上述の代点に鑑みなされてものできり、「ステンの個々の機能に最適な現状技術での製造でのできる。これらの10年のでありつかりもいって相互に接続すりできずチャーのショーを伝われて、クロック信みをテンチチャー間で発信分で伝達する。手段を用いる。自は、・、マエチチャーのしょごを体して、集団までも上し、クロークスポコート伝統、、目的しての集団までも上し、クロークスポコート伝統、、目的しての

[0013]

【理解、解析中心を多く、直接】 と参照、つけできた。これでは、これにより、また、たいでは、したりは、時間に必要を主まれる数数、の場合をできたが開始され、これに登録した。 であった。他のでは、一般のでは、一般のでは、一般の

されたマルチチップモジュールにおいて、前記複数の半導体チップのうち少なくとも1つが受光素子を有し、この受光素子に光信号を与える光信号供給手段を備えたことを特徴とする。

-4

【0014】また、前記複数の半導体チップのうち少ないとも1つは前記光信号を発生する発光素子であることができる。

【0015】さらに、前記記信号供給手段は、前記モジュール基板および前記複数の半導体チップが所定のパッケージに封入され、かつ前記パッケージと前記複数の半導体チップとの間は所定のできるの空洞が設けられ、かつ前記発光素子と前記交光素子以外の前記半導体チップ表面と前記空洞内面および前記モジュール基板表面には前記光信号を反射する反射層が开放されるようにすることできる。

【0016】さらにまた、前記先信号供給手段は、前記 空洞内の上面および側面の少なくとも一方の面上に、外 部に接続された光ファイバー線路の終端部が配設され、 この終端部から前記光信号が前記受光素子に供給される 20 ように構成することもできる。

【0017】また、前記先信号供給手段は、前記モジュール基板および前記複数の主導体研りでが前記パッケージと前記複数の手導体研りでが前記パッケージと前記複数の手導体研りではある。の間は所定の大きさり空間が設けられ、かつ前に発光響子と前記程光离子は入り前記半導体デッで表面および前記モジョール基板表面には前記光信号を吸収する非反射層が形成され、前記空間の面には反射層が形成されるようにすることもできる。

【0018】さらに、前記パッツージで覆われない」なくとも1組のマッチチャプモデュールの前記複数のお享体チャプ搭載面が対向するように所定の距離を保って配置され、一方の前記マルチチップモジュールに前記発光素子が搭載され、他方の前記マルチチャプモジュートに前記段光素子が搭載することができる。

[0019]

【実施例】次にな巻明を区面と参照しなから適明する。 【0020】図1は本発明の第1の《実施例を示す平面 同である。マルチチャでモジュール11の内部に機能で マタ15に発光要差100には手機能でロッタ10元 の光素を101で有する中間なチャで13元、機能でロッタ17元後光速を102を有する平準体チャで14元、発達素差10元はマミチチャでチェルーチ11つ外 を光素差10元はマミチチャでデュルーチー質気付け が増え12元で配限103元でディアーカー質気付け シロニューニー質気と呼ばまた著手10元にどび一位 1、条件されて

【のの出す】と、一個なりを含む機を100、101ました102mm2代で、機能の場合では、機能のあった。 他のまたでは、他のでは、102mm2では、100mm2を10mm2では、115、16、1

7に供給される。

【0022】: こで外部端子12と発光素子19の間の伝搬時間を1.5 n s e c、発光素子19での電気一先変換時間を0.5 n s e c、発光素子19から受光素子102までの光伝搬時間を0.0 n s e c (約1 c m)、発光素子19から受光素子101までの光伝搬時間を0.1 n s e c (約3 c m)、受光素子100、101および102の光一電気信号変換時間およびその近傍の機能でロークまでの遅延時間を1 n s e c とすると、外部端子12から機能ブローク16までは1.5 + 10.5 + 0.1 + 1 = 3.1 n s e c、外部端子12から機能ブロック16と17までは回様に3.03 n s e c となる。、機能でローク16と17とのクロック信号のタイミングスキューは、3.1 = 3.03 = 0.07 n s e c となる。

【0023】この値を前述した図9に示す後来例と比較 してみる。図9では、比較の便宜上図1と機能上等価な ものは全、同じ寸法であるとしている。

【0024】ここで外部端子92と入力端子904間の選延時間を1.5 nsec、入力パッファ望延を1.5 nsec、入力パッファ選延を1.5 nsec、入力パッファ906と機能ブロック96間の選延を4nsecとし、もそ一方の経路で外部端子92、人力端子905の選延を1.1 nsec、機能ブロップ907つ入力パッファ選延を0.5 nsec、機能ブロップ907:97間の選延を1.5 nsecとである。本部端子92から機能ブロック96に至う遅延時間が1.5 nsecとなり、機能ブロック96:97に到る遅延時間が1.1 no.5 + 1.5 = 3.1 nsecとなり、機能ブロック96:97につりロック信号のタイミングスキューは7-3.1 = 3.9 nsecをある。

【0025】103. 9nsecの値と主信号による場合のスキュー0. 07nsecを比較すれば、主信号によるりまったロック伝達が機能動作上同一タイミングを必要しまるマレチチッパキージュール21つ、2が肝の点でのタイミーで達を小さ、する上で圧倒的に有利なことが明らかでもス

【0026】 31のA-A' 関の新面図を示す図2を影照すりと、マンチチンがモジュール11の内部にチップ 13、14および18が配置され、それぞれ徒光素子1 01と102、金光素子19および外部属子12' 対印 している

【0027】 デーニ10、14 および18は、これらせ 一つ関う水部構造121、布接達するためで指線を耐え ことをジェー 高校212上に対戦されている。

【0028】每日基本1010点点点11次的第四,就可以 加速1分型部(人型)211系列搬售工作。所用 11年 2-111 四曜日成年 (人工)企业等的10 1,102。国初,中众未参、中华任于《中、中、中、中、" 6 2.1.1が光を透過することとが光信号供給手段である。

【0029】本発明の第2の実施例の断面図を示す図3を参照すると、光信号はマルチチップもジュール外部から光ファイバー324に導かれて人力される。その終端でマルチチップモジュール内のスペープ321全体に光を散乱させる。その元をチープ313、316上に配置された技光素子325~329が感知し、図1で説明したよりに、その近傍に配置された機能プロックに信号が伝達される。

 θ 【0030】構成要素31、31 $^{\prime}$ 、32 $^{\prime}$ および312 は図2における構成要素11、11 $^{\prime}$ 、12 $^{\prime}$ および2 12と同じできる。

【0032】至4を参照すると、他信号はアード42 4を保機し、使ってたビュール基収412円上郷に空間 424を設けたことが出信号光手設置のもつである。向 モビュール基収412戸左右端の各部端子42はモビュ ー工基収412を平収dの上に固まする役割と、平収d 30 の表面に配された制線に接続し、モビュール基収412 と電気的接続をはたす役割しをそなまたのである。

【0033】第4つ実施例の断面対称はした図るを参照する。、発売者子59から確する光管号か、マンチデンプモジューン51つでパース521内の全紋にできらだけ減衰しないで伝収するように、シーともその表面なり帯戦されているチャブ53つと、ともその表面に、主、文料を含む光ので射効率の良いで射層(繋材)530を備えたものである。特にマルチチープモジューン51つパーで一ジンキージュール基板512に表面処理を変きないでも十分な反射効率が得るわり巻材を用いても良い。

【0004】: わいよって同選に発っておりたが1、1 同ので対で入棄すれた。Cが無利で対象くの対して入射 する光なり、多くい経路の関係があった風襲率である。 しかでき、付け着し501に到るいい難度が順、するこ しかにきる。

【0035】 (また、たいで作す 蓋子501で 他に号をだ いていことに写りました。そうまた号。 台風 (ロジュアア まる)規(個な分でに発験) など。

■ 【0 0 3 6】 ** 一種腔 (事業などが) うずべ と巻・5 0 1

の声での強度の様子を示した図6を参照すると、発光素 子59の光信号が図6-aの波形6aおよび受光素子5 01に到達した経路の異なる先信号が図6-bの波形6 b1、6b2および6b3で、伝搬距離が異なるための 伝達時間に差が生し、また遅い到達する光程は、滅衰も 激しい。

【0037】こう、た到達時間に減衰の度合いの異なる 光が重ね合わされて、結果的に図る一、の波形6bェで 示す信号が受光素子501で受信される。波形のコウレ ウレベルの立下とは、上記の理由で鈍ったものになる。 この鈍りは、信号のバルス幅に比して十分小さいもので あれば通常はほとんと問題にはならない。

【0038】第5○実施例を断面図で示した区7を参照 すぎと、マルチチープモジョー:71のパッケーご内壁 のうち、天井部には光の反射率の良い素材で30が用い られ、その他の分ととも表面部分には反射率が相対的に 低い素材で31が用いられたものである。素材で30お よび731は、特に表面だけに限定されるものでなって ルチチャプモジュール71のコッケーごもし。はモジュー20 テムが実現できる。 一く基板712者のものに契約率の低い素材を用いるこ とも含むもつである。

【0039】なお、図でではマンチチャでも、コーレア 1の時にケーに内面の側面にも同射器が相対的に低い素 材で31が用いたわているか。これにほぎされるもので はな、パッケーご内の側面を含む内面全体に反射性の良 い素材で30を用いてもよい。

【0040】この、引きの構造においては、発出素を19 かりの光信号は、同射率の段に素材で30ではそれは3 滅夷しないで反射されるが、原面の薬材で31に入射し、30 たものはほどんどそこで吸収され、反射して出てしるも Ostiell.

【0041】その信果、受光素ニ701に到達する元信 另つ経路はかなり限らわたもつになる。 この様子を含面 反射率の良い素材を使くた場合・の対化を波平国ではし た図8を影解する。」 皮形8aょ発 名巻その音する 名信 另で図りり場合し異なり、パンス幅は非常に祝い。

【ロロ4日】全面に関射型の高い素材を用いる主、図6 て註明、台場合:同葉の理由工度形861、862およ ひおもはにおす皮形の合物はい種発養子で01で得りむ。 るい、『ハス幅点短』ため早、劉達した名号違と到達し た紀とうできな他国でおりたるに、その途改改は改明8 ではボニュドは、大は名無明度ではなくなった。また。 【0043】渡町80~台州戦の上でいるス結の規制 場 食しては17.6。そんは~色製のターをも水線に示す。 我们一点水。一时,小孩里点,雷阿仁总心多种份撒州中 しまえが、発見しば化られています。 型,激励的低点,由一颗形成的压力。据《发》

[OOM 4] 12 Aug # 12 PT 44 PT 46 PT 141g

会機能が必要になる。

前述したように受光素子701に至る光信号の経路は限 定されるので701で得られる光の強度は弱まるが何相 のマレた光成分がほとんどな。なり、波形8 d ご示すよ うに波形8aに近い矩形波が得られる。この場合は、単 にこの信号を増幅するだけで整形しなくとも十分所定の 機能でロックに供給できるもつである。

8

【0045】また、図7では電気信号系素子に光が照射 されることによる特性変動を防止するために光速蔽素材 732がチップ73の表面に備えられている。素村73 ペルからハイレバルへの立上とおよび、インペルからロー10-2は素材で31と両機能を備えた1つの素材によって素 材732および731との2層構造にするのでなり素材 732だけにしても良い。

[0046]

【発明の効果】上述したようには発明によれば、まず第 1に、クロックなどの高速の信号に元信号を用いるに当 って、それをマルチチェプモジュールの状態で行りこと により、発元素子および受光素子ぞれぞれ心道したチャ プ製造プロセスの適用が可能になる。この結果として、 マルチチェブモジューニ全体として高性能を有するレス

【0041】第2四は、光信号の理想に折い伝搬時間の ためた、フロックスキューが電気信号のなに頼った場合 に比。で著しく低減さた、高性能のレフテムが実現でき る。こらに第3には、元信号の伝達経路のでも、反射す お剖々に反射率の割いものと比較的に低いものとを使い 分けることによって、同信号を受ける位置での光強度、 あるいは彼形をコントロールすることができ、上記高性 能化をより確実なものにすることができる。

【冒笛の簡単な説明】

【図1】は廃明の第1の実施例を示す草面図である。

【図12】図1における点 $\mathbf{A} = \mathbf{A}'$ の断面図である。

【図3】は毎明の第2つ実施例を示す断面図である。

【別4】は毎明の第3つ実施例を示す断面図である。

【図5】 は毎明の第4 り実施例を示す断面図でもら。

【図6】第4の実施倒を説明上もための披形図でわる。 【図1】は商明の第5の英族氏を示す計画図でもら。

【図8】第3つ寒施例外説明する許めの皮形図でもる。

【図9】 生共のマルチチャでモジョールの一個を示す中 面对工程的。

【符字の贈明】

1.1 3.1. 5.1. 7.1 9.1 マルザボップボッコ

15 17 95 97 優報 2 2

18 14 18, 28, 24 28, 58, 58 3 78 93 94 315 316 415 41 6. 417 公園体室

100.101.102.201.202.325 3 420 423, 501, 701 19,29 59,79,419 第三報章

-m 2 f 2 , 3 f 2 , 4 f 2 , 4 f 8 , 5 f 2 , 7 f 2

9

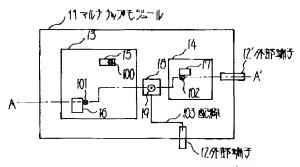
半導体チップを搭載しモジュール基板

٠.

12、12', 22、32, 42, 92 外部端子

10 211,321,424,521,721 スペース (空洞)

図1



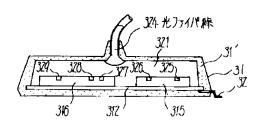
13,14,18:半典体がプ

19: 卷光素于

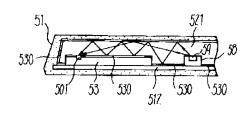
15~17: 機能プロック

100~102:受光素子

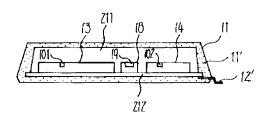
【図3】



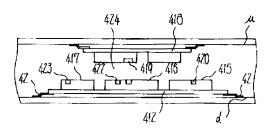
【図5】



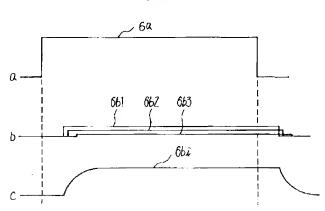
[図2]



【図4】



【図6】



[< 7]

